

電気学会研究会資料目次

電子デバイス研究会

〔委員長〕 和田恭雄（早稲田大）
〔副委員長〕 益 一哉（東工大）
〔幹 事〕 本間哲哉（芝浦工大）、荒川太郎（横国大）
〔幹事補佐〕 大見俊一郎（東工大）

日 時 平成18年3月2日（木） 14：00～17：00
平成18年3月3日（金） 9：00～14：00
場 所 NTT水上保養所「紫明荘」（群馬県利根郡水上町湯檜曾15-1）

テーマ「超高速デバイス・回路技術」

- EDD-06-37 産業競争力強化に貢献する COE コンソーシアムを目指して
渡辺久恒（半導体先端テクノロジーズ）…………… 1
- EDD-06-38 バルクシリコン基板上に形成したゲート長 20nm，フィン幅 6nm の CMOS FinFET の
プロセスインテグレーション技術とデバイス特性
岡野王俊，泉田貴士，川崎博久，金子明生，八木下淳史，金村貴永，
近藤正樹，伊藤早苗，青木伸俊，宮野清孝，小野高稔，矢橋勝典，
岩出健次，窪田壮男，松下貴哉，水島一郎，稲葉 聡，石丸一成，
須黒恭一，江口和弘，綱島祥隆，石内秀美（東芝 セミコンダクター社）…………… 5
- EDD-06-39 Σ 型 SiGe-SD 構造を有する超高速 45nm ノード・バルク CMOS デバイス
大田裕之，金永ソク（富士通）
島宗洋介（富士通研究所）
佐久間 崇（富士通）
畑田明良，片上 朗（富士通研究所）
添田武志，川村和郎，小倉 輝，森岡 博，渡邊崇史
王 純志，早見由香，小倉寿典，田島 貢，森 年史（富士通）
田村直義（富士通研究所）
児島 学，橋本浩一（富士通）…………… 11

EDD-06-40	逆傾斜ヘテロ接合コレクタ構造による HBT コレクタ容量の線形化と 3 次相互 変調歪みの最小化条件の導出	鄭 聡, 石川 亮, 本城和彦 (電気通信大学) …… 17
EDD-06-41	イオン注入法による GaN FET の特性改善効果	野本一貴, 田島 卓, 河村光則, 伊藤伸之, 佐藤政孝, 中村 徹 (法政大学) 葛西 武 (ケミトロニクス) 三島友義 (日立電線) …… 23
EDD-06-42	将来の携帯電話システムに向けた回路・デバイス技術への期待	山尾 泰 (電気通信大学) …… 29
EDD-06-43	パワースイッチングシステム応用に向けての AlGaIn/GaN デバイス	上田哲三, 村田智洋, 中澤敏志, 引田正洋, 黒田正行, 石田秀俊 柳原 学, 井上 薫, 上本康裕, 田中 毅, 上田大助 (松下電器産業) 江川孝志 (名古屋工業大学) …… 35
EDD-06-44	ノンドープ・ノンオーバーラップ構造を用いた超低リーク版 FD-SOI トランジスタ	三浦規之, 堂前泰宏, 坂田豊和, 渡辺 実, 岡村友博, 千葉 正, 福田浩一, 井田次郎 (沖電気工業) …… 41
EDD-06-45	無線通信用 InGaP HBT パワーアンプの高線形化技術	岡 徹, 長谷川正智, 藤田耕一郎, 山下雅治, 平田倫歳, 川村博史, ジョン トワイナム, 作野圭一 (シャープ) …… 45
EDD-06-46	タングステンをオーミック電極に用いた新たな横方向微細化技術による InP 系 HEMT の特性向上	松崎秀昭, 小杉敏彦, 高橋宏行, 徳光雅美, 榎木孝知 (日本電信電話) 丸山隆志 (NTT アドバンステクノロジー) …… 51

共 催 電気学会「高度ワイヤレスユビキタス社会を支える超高速デバイス・回路技術」
調査専門委員会